

a 2008 0235

Invenția se referă la domeniul tehnologiei planare de obținere a straturilor semiconductoare de tip A^4B^6 , în special la un procedeu de obținere a substratului de BaF_2 cu suprafață perfectă.

Procedeul include detașarea sau tăierea sub-stratului inițial de-a lungul direcțiilor cristalografice alese, șlefuirea chimico-mecanică a suprafeței, recoacerea în vid a substratului la temperatura de $973^\circ K$, timp de 30 min, apoi depunerea unui strat suplimentar de BaF_2 în vid supraînalt la temperatura substratului de $1023^\circ K$, timp de 3...5 min, cu controlul neîntrerupt al calității suprafeței prin metoda difracției electronilor rapizi.

Revendicări: 1

Figuri: 3